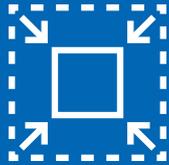


利用 SiC 产品为实现

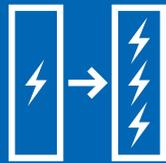
高效化



小型化



高功率密度化



提供支持

通过优化表面构造和利用薄晶片技术，与旧型产品（第 1 代 SiC 肖特基势垒二极管）相比，实现了低导通损耗（低 V_F ）、高浪涌耐量（高 I_{FSM} ）、高散热。以此为进一步实现电源的高效化、小型化、高功率密度化提供支持。



· 实现高效电源

通过低 V_F 化，导通损耗比旧型产品减少约 18%

· 减少元件温度上升

在整个温度范围内，与旧型产品相比，进一步实现了低导通损耗

· 提高可靠性

元件对正向浪涌电流的耐受能力提高约 64%



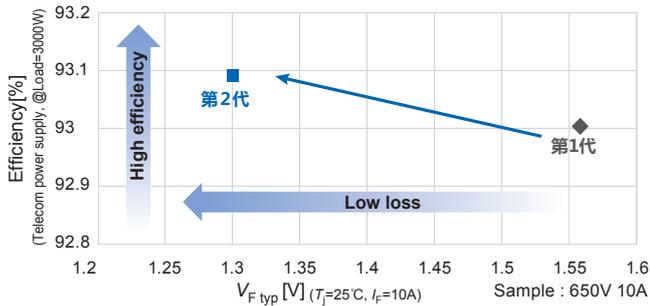
封 装：TO-220-2、TO-220F-2、TO-247-2
用途示例：服务器、通信设备、UPS、功率调节器、通用电源、EV用快速充电器等



1. 实现高效电源

通过低 V_F 化，与旧型产品相比，导通损耗可减少约 18%。
有助于进一步实现电源的高效化、小型化、高密度化。

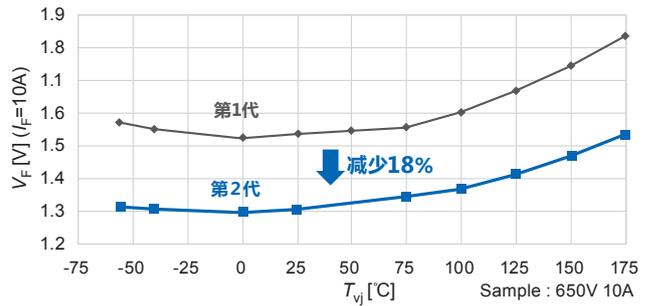
V_F - Efficiency



2. 减少元件温度上升

与旧型产品相比，在整个温度范围内实现低 V_F 化（比旧型产品减少约 18%）。

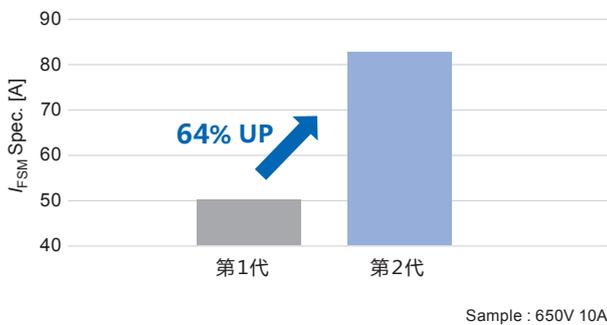
$V_F - T_j$



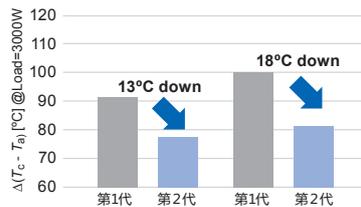
3. 提高可靠性

同时实现低 V_F 化和高浪涌耐量 (I_{FSM})。
 I_{FSM} 保证值与旧型产品的 50A 相比，提高至 82A（提高 64%）

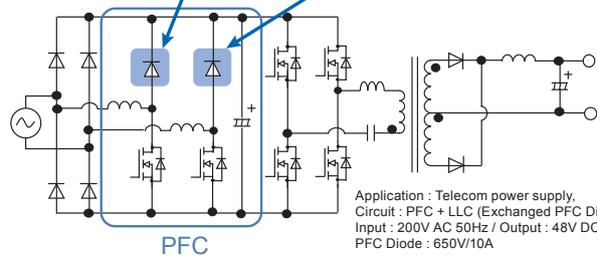
I_{FSM}



Temperature rise



只需将旧型产品替换为第 2 代 SiC-SBD，便可将元件的上升温度减少 18°C



产品系列

Rated Voltage	I_F [A]	6	8	10	20	40
650V	TO-220-2	FDC2PT06S65	FDC2PT08S65	FDC2PT10S65		
	TO-220F-2	FDC2AT06S65	FDC2AT08S65	FDC2AT10S65		
1200V	TO-247-2				FDC2WT20S120	FDC2WT40S120

安全相关注意事项

- *使用前请仔细阅读“使用说明书”和“规格书”或咨询本公司或您购买产品的店铺后适当使用。
- *请委托拥有本领域专业技术的人员进行处理。

富士电机株式会社

URL www.fujielectric.com/products/semiconductor/cn/
Gate City Ohsaki, East Tower, 1-11-2, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, Japan Tel: +81-3-5435-7156

- 富士电机（中国）有限公司 上海市普陀区凯旋北路 1188 号环球港 B 座 26 楼 Tel: +86-21-5496-1177
- 富士电机（香港）有限公司 九龍旺角太子道西 193 號新世紀廣場第二座 16 字樓 1601-1603 及 05 室 Tel: +852-2664-8699
- 台湾富士电机股份有限公司 10459 台北市中山區松江路 168 號 10 樓 Tel: +886-2-2511-1820

2022-3 FOLS PDF

本文档的内容如有更改，恕不另行通知。